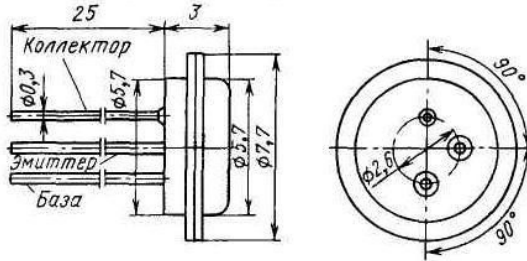


2Т301Г, 2Т301Д, 2Т301Е, 2Т301Ж, КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е, КТ301Ж

Транзисторы кремниевые планарные *n-p-n* универсальные высокочастотные маломощные
Предназначены для применения в усилительных и генераторных схемах радиоэлектронной аппаратуры
Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора не более 0,5 г.



Электрические параметры

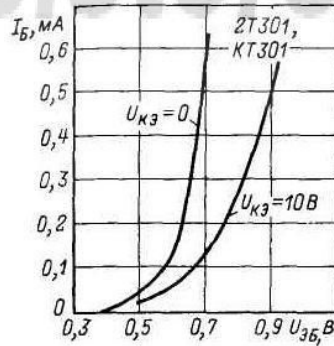
Максимальная частота генерации при $U_{КБ} = 10$ В, $I_3 = 3$ мА не менее	60 МГц
Модуль коэффициента передачи тока при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_3 = 3$ мА, $f = 20$ МГц не менее	1,5
Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{КБ} = 10$ В, $I_3 = 2$ мА, $f = 2$ МГц не более	
2Т301Г, 2Т301Д, КТ301Г, КТ301Д	4,5 нс
2Т301Е, 2Т301Ж, КТ301Е, КТ301Ж	2,0 нс
Время рассасывания при $I_к = 10$ мА, $I_Б = 1$ мА не более	
2Т301Г, 2Т301Д, КТ301Г, КТ301Д	5 мкс
2Т301Е, 2Т301Ж, КТ301Е, КТ301Ж	8 мкс
Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 10$ В, $I_3 = 3$ мА	
2Т301Г, КТ301Г	10 — 32
2Т301Д, КТ301Д	20 — 60
2Т301Е, КТ301Е	40 — 120
2Т301Ж, КТ301Ж	80 — 300
Граничное напряжение при $I_3 = 10$ мА, $\tau_{и} = 5$ мкс не менее	
2Т301Г, 2Т301Д	30 В
2Т301Е, 2Т301Ж	20 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_к = 10$ мА, $I_Б = 1$ мА не более	3 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_к = 10$ мА, $I_Б = 1$ мА не более	2,5 В
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 10$ В $f = 2$ МГц не более	10 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0,5$ В $f = 2$ МГц не более	80 пФ
Обратный ток коллектора при $T = 298$ К $U_{КБ} = U_{КБ, макс}$ не более	
2Т301Г, 2Т301Д, 2Т301Е, 2Т301Ж	5 мкА
КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е, КТ301Ж	10 мкА
при $T = 398$ К $U_{КБ} = 10$ В не более	
2Т301Г, 2Т301Д, 2Т301Е, 2Т301Ж	50 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 3$ В не более	
2Т301Г, 2Т301Д, 2Т301Е, 2Т301Ж	50 мкА
КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е, КТ301Ж	10 мкА
Выходная проводимость при $U_{КБ} = 10$ В, $I_3 = 3$ мА, $f = 1$ кГц не более	3,0 мксм

Предельные эксплуатационные данные

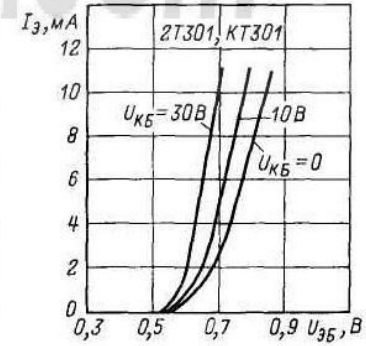
Постоянное напряжение коллектор-база и коллектор-эмиттер	
2Т301Г, 2Т301Д, КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е, КТ301Ж	30 В
2Т301Е, 2Т301Ж	20 В
Напряжение эмиттер база	3 В
Напряжение коллектор-эмиттер при котором h_{213} сохраняется в пределах установленных норм при $I_3 = 3$ мА не менее	2 В
Постоянный ток коллектора и эмиттера	10 мА
Импульсный ток коллектора при $\tau_{и} \leq 1$ мкс, $Q \geq 2$	20 мА
Постоянная рассеиваемая мощность	
при $T \leq 333$ К	150 мВт
при $T = 398$ К 2Т301Г, 2Т301Д, 2Т301Е, 2Т301Ж	42 мВт
при $T = 358$ К КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е, КТ301Ж	58 мВт
Температура перехода	
2Т301Г, 2Т301Д, 2Т301Е, 2Т301Ж	423 К
КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е, КТ301Ж	393 К
Общее тепловое сопротивление	0,6 К/мВт
Температура окружающей среды	
2Т301Г, 2Т301Д, 2Т301Е, 2Т301Ж	От 213 до 398 К
КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е, КТ301Ж	От 233 до 358 К

Примечание При монтаже допускается пайка выводов на расстоянии не менее 5 мм от корпуса Пайку следует производить паяльником за время не более 10 с Температура пайки не должна превышать 533 К Необходимо осуществлять теплоотвод между корпусом и местом пайки

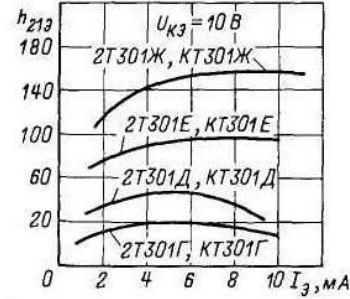
Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора, при этом должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие неподвижность выводов между местом изгиба и стеклянным изолятором, чтобы не произошло нарушения спая вывода со стеклянным изолятором, ведущего к потере герметичности транзистора



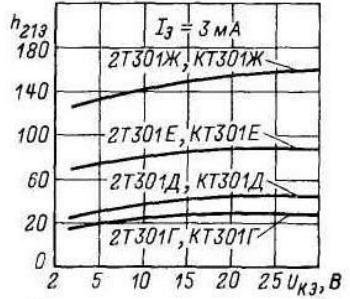
Входные характеристики



Зависимость тока эмиттера от напряжения эмиттер-база



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор-эмиттер